(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012 年 12 月 27 日(27.12.2012)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2012/176351 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/301 (2006.01) *C09J 133/20* (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01) *C09J 201/00* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2011/078471

(22) 国際出願日: 2011 年 12 月 8 日(08.12.2011)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2011-141266 2011 年 6 月 24 日(24.06.2011) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 古河電気工業株式会社 (**FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.**) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内２丁目２番３号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 青山 真沙美 (**AOYAMA, Masami**) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内２丁目２番３号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 石渡 伸一 (**ISHIWATA, Shinichi**) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内２丁目２番３号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 矢吹 朗 (**YABUKI, Akira**) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内２丁目２番３号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 石黒 邦彦 (**ISHIGURO, Kunihiko**) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内２丁目２番３号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 鈴木 俊宏 (**SUZUKI, Toshihiro**) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内２丁目２番３号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 飯田 敏三, 外 (**IIDA, Toshizo** et al.); 〒1050004 東京都港区新橋３丁目１番１０号 石井ビル３階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

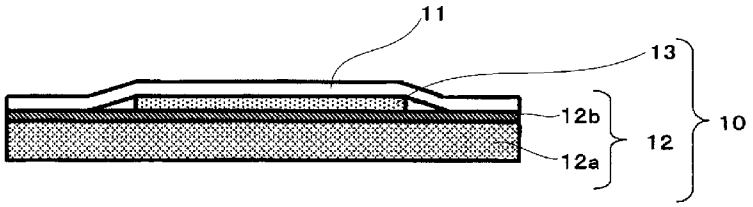
添付公開書類:

— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）

(54) **Title**: WAFER WORKING TAPE

(54) 発明の名称 : ウェハ加工用テープ

[図1]



(57) **Abstract**: Provided is a wafer working tape wherein a support substrate, an adhesion layer, and a single binding layer are stacked in this order. The binding layer is used for pressure adhesion of a semiconductor element to either an external contact wiring member with wiring or another semiconductor element. The difference in surface free energy between the face of the binding layer which has detached from the adhesion layer and the face of the binding layer which is not in contact with the adhesion layer is 10 mJ/m^2 or less.

(57) 要約: 支持基材と粘着剤層と単層の接着剤層とがこの順に積層されたウェハ加工用テープで、前記接着剤層は半導体素子を配線付き外部接続用配線部材または別の半導体素子に圧着するために用いられる接着剤層であって、前記接着剤層の粘着剤層から剥離した面と粘着剤層に接しない面の表面自由エネルギー差が１０ｍＪ／ｍ^{2}以下であるウェハ加工用テープ。

WO 2012/176351 A1